



Universität Stuttgart



Institut für  
Robuste  
Leistungshalbleitersysteme

# Fachpraktikum (Bachelor)

## 6G HARDWARELABOR - DESIGN UND IMPLEMENTIERUNG EINES HF TRANSCEIVERS

---

### Versuch 2: Auslegung eines HF-Verstärkers

---

**Protokollführer**

Lukas Müller

Erik Zimmermann

Farhad Valizada

**Betreuer**

Simon Haussmann

**Eingereicht**

May 15, 2025

# Inhaltsverzeichnis

<b>Abkürzungsverzeichnis</b>	<b>3</b>
<b>1 Einleitung(Farhad)</b>	<b>4</b>
1.1 Ziel des Versuchs . . . . .	4
1.2 Relevanz und Anwendungsbereiche von HF-Verstärkern . . . . .	4
<b>2 Theoretische Grundlagen(Lukass)</b>	<b>5</b>
2.1 Funktion eines HF-Verstärkers . . . . .	5
2.2 Arbeitspunkteinstellung . . . . .	5
2.3 Bedeutung der S-Parameter . . . . .	5
2.4 (rolle kopplungskodensator) . . . . .	5
<b>3 HF-Simulation(Charhad)</b>	<b>6</b>
3.1 Inbetriebnahme von Keysight Advanced Design System (ADS) . . . . .	6
3.1.1 Installation von ADS . . . . .	6
3.1.2 Erstellen eines neuen Projekts . . . . .	6
3.1.3 Vertrautmachen mit der Benutzeroberfläche . . . . .	7
3.2 Analyse des Datenblattes zu Transistor BFR181W . . . . .	7
3.3 DC-Simulation . . . . .	7
3.4 S-Parameter-Simulation . . . . .	7
<b>4 Technische Umsetzung(Erik)</b>	<b>8</b>
4.1 Platinen Aufbau . . . . .	8
4.2 DC-Pegel Verifizieren . . . . .	8
4.3 Kalibrierung . . . . .	8
4.4 Vergleich zur Simulation . . . . .	8
<b>5 Diskussion der Ergebnisse(GangBang)</b>	<b>10</b>
5.1 Vergleich von Theorie und Praxis . . . . .	10
5.2 Erklärung von Abweichungen . . . . .	10
<b>6 Fazit(Jeder)</b>	<b>11</b>
6.1 Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse . . . . .	11
6.2 Reflexion und mögliche Verbesserungen . . . . .	11
6.3 Eigene Reflexion . . . . .	11
6.3.1 Erik . . . . .	11
6.3.2 Farhad . . . . .	11
6.3.3 Lukas . . . . .	11

---

<b>7</b>	<b>Literaturverzeichnis</b>	<b>12</b>
7.1	Quellen . . . . .	12
7.1.1	Literaturverzeichnis . . . . .	12

# Abkürzungsverzeichnis

<b>ADS</b>	Advanced Design System
<b>HF</b>	Hochfrequenz
<b>6G</b>	Sixth Generation
<b>SMA</b>	SubMiniature version A
<b>PCB</b>	Printed Circuit Board

# Kapitel 1

## Einleitung(Farhad)

### 1.1 Ziel des Versuchs

blabla test

### 1.2 Relevanz und Anwendungsbereiche von HF-Verstärkern

blabla

## Kapitel 2

# Theoretische Grundlagen(Lukass)

2.1 Funktion eines HF-Verstärkers

2.2 Arbeitspunkteinstellung

2.3 Bedeutung der S-Parameter

2.4 (rolle kopplungskodensator)

blabla

## Kapitel 3

# HF-Simulation(Charhad)

### 3.1 Inbetriebnahme von Keysight Advanced Design System (ADS)

#### 3.1.1 Installation von ADS

Die Software Advanced Design System ([ADS](#)) dient zur Simulation von Schaltungen verschiedener Komplexitätsgrade. In diesem Versuch wird die Software verwendet, um eine Hochfrequenzschaltung zu simulieren und zu analysieren. Die Software bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter die Möglichkeit, Schaltungen zu entwerfen, S-Parameter zu simulieren und verschiedene Analysewerkzeuge zu verwenden.

#### 3.1.2 Erstellen eines neuen Projekts

Die Software ist auf den Rechnern im Labor bereits installiert gewesen. Nach dem Start der Software wird ein neues Projekt aus den bereits zur Verfügung stehenden Workspaces erstellt. Diese sind auf der ILIAS-Seite des Praktikums in dem Dateiarchiv `TransmitterAmpDesign 2024.zip` hinterlegt. Die Datei wird entpackt und in der Software geöffnet. Außerdem werden die benötigten Bibliotheken aus dem Dateiarchiv `Infineon-RFTransistor-Keysight ADS Design Kit-SM-v02 10-EN.zip` geladen, diese stehen ebenfalls auf der ILIAS-Seite zur Verfügung.

---

### 3.1.3 Vertrautmachen mit der Benutzeroberfläche

Schließlich werden die Tutorials 1 und 2 von [ADS](#) durchgearbeitet, um sich mit der Benutzeroberfläche und den grundlegenden Funktionen der Software vertraut zu machen. Am Anfang der Schaltungsanalyse wird das Schema `TX_Amp.dds` geöffnet.

## 3.2 Analyse des Datenblattes zu Transistor BFR181W

Um die Schaltung zu simulieren, wird der Transistor BFR181W verwendet. Um die genauen Parameter des Transistors zu kennen, wird das Datenblatt des Transistors analysiert. Dieses steht auch auf der ILIAS-Seite des Praktikums zur Verfügung.

Die Tabelle “Maximum Ratings at  $T_A = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified” unten links auf Seite 1 des Dokuments zeigt, dass der maximal zulässige Kollektorstrom  $I_{C,\text{max}}$  20 mA beträgt.

## 3.3 DC-Simulation

Im folgendem wird eine DC-Simulation der später aufzubauenden Schaltung durchgeführt. Außerdem werden die Arbeitspunkte optimal durch die Anpassung der Widerstandswerte eingestellt. Die DC-Simulation wird in [ADS](#) durchgeführt, um die DC-Pegel der Schaltung zu überprüfen.

Folgende Spannungswerte werden angenommen:

- $V_{CC} = 4.8\text{ V}$
- $V_{BE} = 0.77\text{ V}$

Der Kollektorwiderstand  $R_5$  wird auf  $330\ \Omega$  eingestellt, um den Kollektorstrom  $I_C$  auf 10 mA zu setzen.

## 3.4 S-Parameter-Simulation

blabla



## Kapitel 4

# Technische Umsetzung(Erik)

### 4.1 Platinen Aufbau

### 4.2 DC-Pegel Verifizieren

### 4.3 Kalibrierung

### 4.4 Vergleich zur Simulation

---

adkafdkadfasdkl

## Kapitel 5

# Diskussion der Ergebnisse(GangBang)

### 5.1 Vergleich von Theorie und Praxis

### 5.2 Erklärung von Abweichungen

bla bla

# Kapitel 6

## Fazit(Jeder)

6.1 Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse

6.2 Reflexion und mögliche Verbesserungen

6.3 Eigene Reflexion

6.3.1 Erik

6.3.2 Farhad

6.3.3 Lukas

bla bla

## Kapitel 7

# Literaturverzeichnis

### 7.1 Quellen

#### 7.1.1 Literaturverzeichnis